FEATURES

持 征

Power dissipation (最大耗散功率)

cm : 0.625 W Tamb=25 °C)

Collector current (最大集电极电流)

см : 0.5 A

Collector-base voltage (集电极--基极击穿电压)

V : 45



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25 °C unless otherwise specified)

电 特性 (环境温度 除 非 另 有 规 定)

Parameter 参数	Symbol 符 号	Test conditions 测 试 条 件	MIN 最小值	TYP 典型值	MAX 最大值	UNIT 单 位
Collector-base breakdown voltage 集电极 - 基极击穿电压	V(BR) _{CBO}	Ic= 100 ^{II} A 1 _E =0	45			V
Collector-emitter breakdown voltage 集电极发射极击穿电压	V(BR) _{CEO}	Ic= 0. 1 mA, I _B =0	25			V
Emitter-base breakdown voltage 发射极基极击穿电压	V(BR) _{EBO}	I _E = 100 ^μ A 'I _C =0	5			V
Collector cut-off current 集电极基极截止电流	СВО	V _{CB} = 40 V I _E =0			0.1	μА
Collector cut-off current 集电极发射极截止电流	CEO	V _{CE} = 20 V I _B =0			0.1	μА
Emitter cut-off current 发射极基极截止电流	EBO	V _{EB} = 5 V, I _C =0			0.1	μА
DC current gain(note) 直流电流增益	H FE(1)	V _{CE} = 1 V, I _C = 50 mA	64		300	
	H FE ⁽²⁾	V _{CE} = 1V, I _C =500 mA	40			
Collector-emitter saturation voltage 集电极发射极饱和压降	V _{CE} (sat)	I _C = 500 mA, I _B =50 mA			0.6	V
Base-emitter saturation voltage 基极发射极饱和压降	V _{BE} (sat)	I _C = 500mA, I _B = 50 mA			1.2	V
Base-emitter voltage 基 极 发 射 极 正向电压	V BE	I _E =100mA			1.4	V
Transition frequency 特 征 频 率	f _⊤	V_{CE} = 6 V, I_{C} = 20 mA f =30MHz	150			MHz

CLASSIFICATION OF FE(1) (分类)

Rank 档次	D	Е	F	G	Н	I
Range 范 围	64-91	78-112	96-135	112-166	144-220	190-300

Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd. Homepage: http://www.wingshing.com

Tel:(852)2341 9276 Fax:(852)2797 8153

E-mail: wsccltd@hkstar.com